

ブリッジ型 Bridge Diode

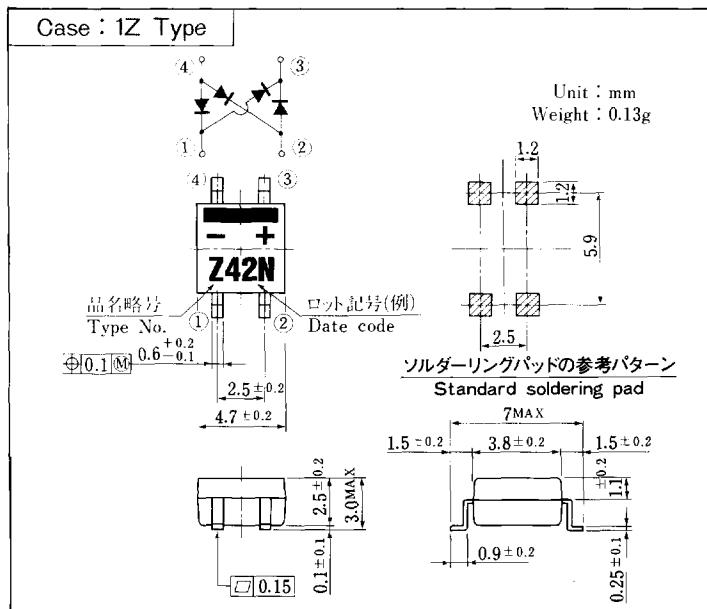
一般整流ダイオード Rectifier Diode

S1ZB□

600V 0.8A



■ 外形寸法図 OUTLINE DIMENSIONS



■ 定格表 RATINGS

絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings

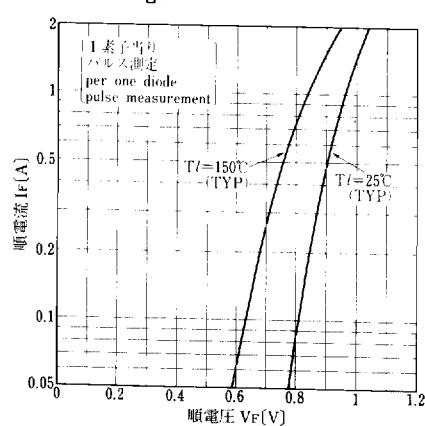
項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	S1ZB10	S1ZB20	S1ZB40	S1ZB60	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	Tstg			-40~150				°C
接合部温度 Operating Junction Temperature	Tj			150				°C
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V _{RM}			100	200	400	600	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	I _O	50Hz 正弦波, 抵抗負荷, T _a =25°C 50Hz sine wave, R-load, T _a =25°C	アルミナ基板実装 On alumina substrate プリント基板実装 On glass-epoxy substrate	0.8				A
せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current	I _{FSM}	50Hz 正弦波, 非繰り返し1サイクルせん頭値, T _j =25°C 50Hz sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value, T _j =25°C		30				A

電気的・熱的特性 Electrical Characteristics (T_l=25°C)

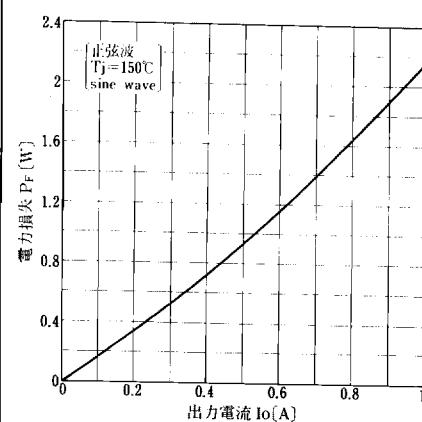
順電圧 Forward Voltage	V _F	I _F =0.4A, パルス測定, 1素子当りの規格値 I _F =0.4A, Pulse measurement, Rating of per diode	MAX 1.05	V
逆電流 Reverse Current	I _R	V _R =V _{RM} , パルス測定, 1素子当りの規格値 V _R =V _{RM} , Pulse measurement, Rating of per diode	MAX 10	μA
熱抵抗 Thermal Resistance	θ _{jl}	接合部・リード間 Junction to lead	MAX 20	°C/W
	θ _{ja}	接合部・周囲間 Junction to ambient	MAX 76 MAX 134	

■ 特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS

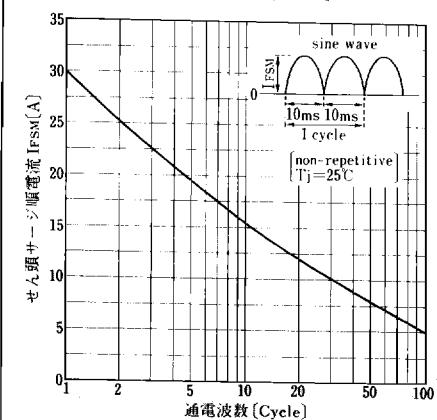
順方向特性
Forward Voltage



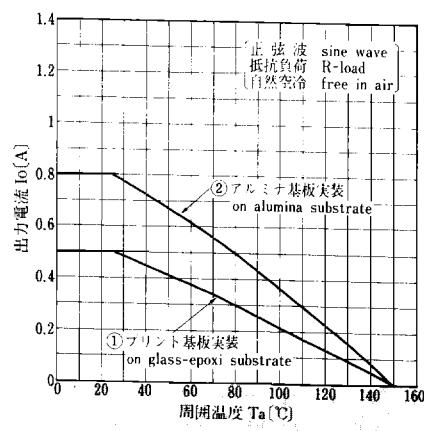
電力損失曲線
Power Dissipation



せん頭サージ順電流耐量
Surge Forward Current Capability



ディレーティングカーブ T_a — I_o
Derating Curve T_a — I_o



	①	②
フリントランド soldering land	1 mm	1 mm
導体箔 conductor layer	35 μm	20 μm
基板の厚さ substrate thickness	0.64mm	